

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成29年2月9日 (2017.2.9)

【公開番号】特開2016-208046(P2016-208046A)

【公開日】平成28年12月8日 (2016.12.8)

【年通号数】公開・登録公報2016-067

【出願番号】特願2016-141167(P2016-141167)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/8234 (2006.01)

H 0 1 L 27/088 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

H 0 1 L 21/336 (2006.01)

H 0 1 L 21/8242 (2006.01)

H 0 1 L 27/108 (2006.01)

H 0 1 L 27/10 (2006.01)

H 0 1 L 27/146 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 27/08 1 0 2 E

H 0 1 L 29/78 6 1 3 Z

H 0 1 L 29/78 6 1 8 B

H 0 1 L 29/78 6 2 7 F

H 0 1 L 27/10 3 2 1

H 0 1 L 27/10 4 6 1

H 0 1 L 27/14 C

【手続補正書】

【提出日】平成28年12月14日 (2016.12.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

レジスタアレイと、

前記レジスタアレイと機能的に接続されている A L U と、

前記 A L U と機能的に接続されている命令レジスタと、を有し、

前記レジスタアレイ、前記 A L U 及び前記命令レジスタの少なくとも一は、第 1 のトランジスタと、前記第 1 のトランジスタ上方の第 2 のトランジスタと、を有し、

前記第 1 のトランジスタのチャネル形成領域は、シリコンを有し、

前記第 2 のトランジスタは、チャネル形成領域を酸化物半導体層に有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のトランジスタのソース電極又はドレイン電極の一方と電氣的に接続されていることを特徴とする処理装置。

【請求項 2】

レジスタアレイと、

前記レジスタアレイと機能的に接続されている A L U と、

前記 A L U と機能的に接続されている命令レジスタと、を有する処理装置であって、

前記処理装置の一部は、第 1 のトランジスタと、第 2 のトランジスタと、を有し、

前記第 2 のトランジスタは、チャネル形成領域を酸化物半導体層に有し、

前記第 1 のトランジスタのゲート電極は、前記第 2 のトランジスタのソース電極又はドレイン電極の一方と電氣的に接続されていることを特徴とする処理装置。

【請求項 3】

請求項 1 又は請求項 2 に記載の処理装置の作製方法であって、

第 1 の熱処理を経て前記酸化物半導体層を形成し、

前記第 1 の熱処理の処理中に、不活性ガスを含む雰囲気から酸素を含む雰囲気に切り替えることを特徴とする処理装置の作製方法。